

# 2SB1016

シリコンPNP三重拡散形

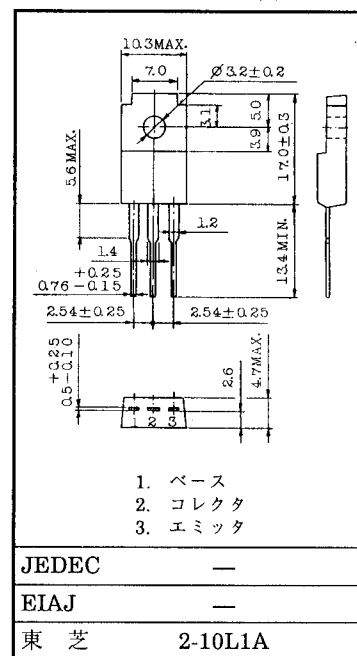
○ 電力増幅用

- 高耐圧です。 :  $V_{CEO} = -100V$
- 飽和電圧が小さい。 :  $V_{CE(sat)} = -2.0V$  (最大)
- 2SD1407とコンプリメンタリになります。

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-100	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-5	A
ベース電流	$I_B$	-0.5	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ C$ )	$P_C$	30	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$

単位 : mm



電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	—	—	-100	$\mu A$
エミッタしゃ断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-1	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-100	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -4A$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -4A, I_B = -0.4A$	—	—	-2.0	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -4A$	—	—	-1.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -5V, I_C = -1A$	—	5	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0,$ $f = 1MHz$	—	270	—	pF

注 :  $h_{FE(1)}$  分類 R : 40~80, O : 70~140, Y : 120~240